*HJU1020 高速全波整流桥

一、概述

HJU1020 高速全波整流桥是将高速整流晶体管装配在 TO-257F 金属全密封外壳内,采用氧化铍 (BeO) 基片隔离,保证器件具有非常低的热阻,提高了效率和可靠性。主要应用在开关电源和逆变器中做整流用,也可作为单独二极管使用,或在 H 桥驱动电路中作续流二极管用。

主要特点如下:

非常低的反向恢复时间(t_{rr}=25ns)

低的正向导通电压($V_F=0.75V$)

高的反向工作电压(V_R=200V)

高的正向工作电流(I_F=10A)

二、电原理图及封装形式

器件采用 TO-257F 金属全密封外壳封装,外形尺寸见附录一图 23。

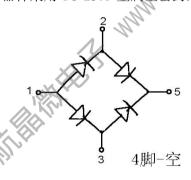


图 1 电原理图

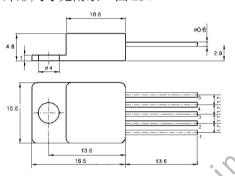


图 2 外形尺寸图

三、绝对最大额定值

工作结温 Tī

+200°C

贮存温度 Tstg

-65~200 ℃

引线耐焊接温度(10S)

+300°C

耗散功率 1.5W (超功率应用须加散热器)

四、电特性

除非另有说明, T_A=+25℃。

参数名称	符号	测试条件	规范值			单位
			最小值	典型值	最大值	1 平位
反向击穿电压	V _R	I _R =10μA	200			V
峰值重复电流	I_{FM}	20kHz,方波 T _C =150℃	10			A
正向导通电压 *	V_{F}	I _F =8A		0.65	1.35	V
		$I_F = 8A$, $T_C = 175$ °C		0.75	1.32	
反向漏电流	I_R	$V_R = V_{RWM}$			10	μΑ
		$V_R = V_{RWM}$, $T_C = 175$ °C			300	
反向恢复时间 **	t _{rr}	$I_F = 0.5A$, $I_R = 1.0A$		25		ns

注:*对单个整流二极管测试,正向导通电压采用脉冲法测试,脉冲宽度=300μs,脉冲占空比≤2%。 **设计保证